Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»

Кафедра электронных приборов

Технология приборов оптической электроники и фотоники

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Методические указания к лабораторной работе для студентов направления 200700.62 — Фотоника и оптоинформатика

УДК 621.7-51(076.5)

Орликов, Леонид Николаевич.

Подготовка к проведению технологического процесса = Технология приборов оптической электроники и фотоники: методические указания к лабораторной работе для студентов направления 200700.62 – Фотоника и оптоинформатика / Л. Н. Орликов; Министерство образования и науки Российской Федеральное Федерации, государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования управления Томский государственный университет систем радиоэлектроники, Кафедра электронных приборов. - Томск: ТУСУР, 2013. -12 c.

В данной пособие рассмотрены инструкции и рекомендации по работе с наиболее употребляемыми приборами, применяемыми для подготовки и проведения технологических операций формирования элементов фотоники и оптоинформатики. В работе рассмотрены: порядок измерения форвакуума и высокого вакуума, методика оценки адгезии пленки, методика измерения расхода рабочего газа, методика измерения толщины пленки и коэффициента преломления.

В ходе выполнения работы у студентов формируются:

- способность оценивать научную значимость и перспективы прикладного использования результатов исследования (ПК-14);
- способность разрабатывать элементы и устройства фотоники и оптоинформатики на основе существующей элементной базы (ПК-20);
- способность выбирать необходимое оборудование и способ контроля параметров устройства (ПК-21);
- способность конструировать В соответствии c техническим оптические заданием типовые И оптоинформационные системы компьютерного использованием стандартных средств проектирования; проводить расчеты (ПК-25).

Предназначено для студентов очной и заочной форм, обучающихся по направлению «Фотоника и оптоинформатика» по курсу «Технология приборов оптической электроники и фотоники».

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»

Кафедра электронных приборов

УТВЕРЖДА	Ю
Зав.кафедрой	ЯΕ
	С.М. Шандаров
«»	2013 г.

Технология приборов оптической электроники и фотоники

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Методические указания к лабораторной работе для студентов направления 200700.62 — Фотоника и оптоинформатика

Разрабо	тчик
д-р техн	і. наук, проф.каф.ЭП Л.Н.Орликов
<u> </u>	2013 г

Содержание

	1 Введение	5
2	Порядок выполнения работы и методические указания	6
	2.1 Методика измерения вакуума	6
	2.1.1 Измерение форвакуума (P<10 ⁻³ мм рт ст)	6
	2.1.2 Измерение высокого вакуума (термопарный прибор должен	
	«зашкаливать»)	7
	2.2 Методика измерения адгезии пленки	
	2.3 Методика измерения расхода газа	
	2.4 Методика измерения толщины пленки на эллипсометре	
	2.4.1 Измерение металлической пленки по пропусканию лазерного	
	излучения	8
	2.4.2 Измерение толщины прозрачной пленки и показателя ее	
	преломления	8
	3 Задание	
	3.1 Задание по измерению вакуума	9
	3.2 Задание по измерению адгезии пленки	
	3.3 Задание по измерению расхода газа	
	3.4 Задание по измерению толщины пленки на эллипсометре	10
	4 Содержание отчета	11
Pe	екомендуемая литература	

1 Введение

В пособие рассмотрены инструкции и рекомендации по работе с наиболее употребляемыми приборами, применяемыми для подготовки и проведения технологических операций формирования элементов фотоники и оптоинформатики. В работе рассмотрены: порядок измерения форвакуума и высокого вакуума, методика оценки адгезии пленки, методика измерения расхода рабочего газа, методика измерения толщины пленки и коэффициента преломления

Лабораторная работа направлена на формирование следующих компетенций:

- способность оценивать научную значимость и перспективы прикладного использования результатов исследования (ПК-14);
- способность разрабатывать элементы и устройства фотоники и оптоинформатики на основе существующей элементной базы (ПК-20);
- способностью выбирать необходимое оборудование и способ контроля параметров устройства (ПК-21);
- способность конструировать в соответствии с техническим заданием типовые оптические и оптоинформационные системы с использованием стандартных средств компьютерного проектирования; проводить расчеты (ПК-25).

В результате изучения дисциплины студент должен

- знать:

- физические принципы работы приборов электроники и наноэлектроники;
- основные приемы построения последовательностей технологических операций изготовления приборов электроники и наноэлектроники;

- уметь:

- 1) ориентироваться в многообразии современных приборов электроники и наноэлектроники;
- 2) разрабатывать принципиальные схемы реализации технологий по изготовлению приборов электроники;
- 3) определять экспериментальным или расчетным путем оптимальные технологические режимы формирования фрагментов электронных приборов;
- 4) использовать для выполнения отдельных операций стандартные программные продукты.

2 Порядок выполнения работы и методические указания

Перед выполнением работы следует дать «прогреться» аппаратуре и приборам для уменьшения дрейфа усилителей и установления стационарных процессов. При измерении форвакуума время между измерениями не должно быть короче 90 секунд, а при измерении высокого вакуума межоперационное время составляет 5-15 минут.

2.1 Методика измерения вакуума

На рис 2.1 представлен условный вид ионизационно-термопарного вакууметра.

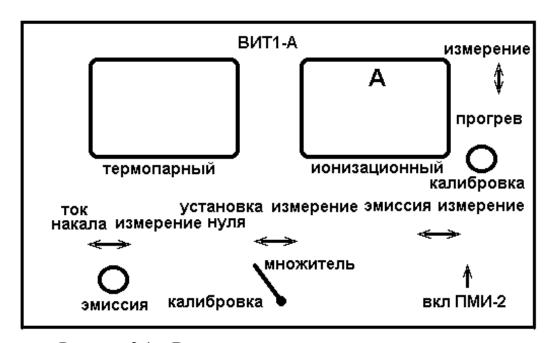


Рисунок 2.1 – Вид ионизационно-термопарного вакуумметра

Перед включением вакуумметра все ручки и тумблеры перевести влево-вниз.

2.1.1 Измерение форвакуума (Р<10⁻³ мм рт ст)

- 1. Перевести тумблер под термопарным прибором в положение ТОК НАКАЛА
 - 2. Установить ток накала 120 мА.
- 3. Перевести тумблер под термопарным прибором в положение ИЗМЕРЕНИЕ

2.1.2 Измерение высокого вакуума (термопарный прибор должен «зашкаливать»)

- 1. Включить тумблер ПМИ2
- 2. Перевести все тумблеры в положение ИЗМЕРЕНИЕ
- 3. Множителем шкалы установить отсчет
- 4. Установка нуля, эмиссии и калибровки проверяется переключением соответствующего тумблера (остальные тумблеры остаются в положении ИЗМЕРЕНИЕ)

2.2 Методика измерения адгезии пленки

Качественно адгезия оценивается стиранием пленки с помощью ногтя или резинки. Количественное измерение адгезии проводится путем наклейки на пленку шпильки диаметром 8 мм с помощью так называемого в продаже «суперклея». По истечении некоторого времени шпильку отрывают от пленки через динамометр.

2.3 Методика измерения расхода газа

Расход газа в широком диапазоне давлений измеряют по количеству воздуха, поглощенного вакуумной системой в единицу времени. Для удобства отсчета воздух откачивают из трубки с делениями, которая соединена с шариком, содержащим вакуумное масло. На рис. 10.2 представлена схема расходомера.



Рисунок 2.2 – Схема расходомера

При измерении расхода засекают время, за которое поднимается 1 см³. Далее поток пересчитывают по соотношению:

$$1 \text{ cm}^3 \text{атм/c} = 2,4 * 10^{-4} \text{ торл/c}.$$

2.4 Методика измерения толщины пленки на эллипсометре

2.4.1 Измерение металлической пленки по пропусканию лазерного излучения

На рис.2.3 представлена схема эллипсометра ЛЭМ-2 для измерения толщины пленки по просвету лазерного излучения.

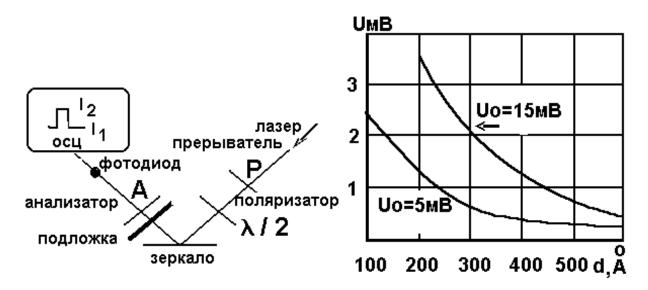


Рисунок 2.3 – Схема эллипсометра и его градуировочные кривые для измерения толщины пленки на просвет

Первоначально без подложки устанавливается уровень опорного сигнала *Uo* с фотодиода. Затем в луч лазера, отраженный от зеркала, вставляется подложка. По изменению сигнала оценивается толщина пленки. В ряде случаев толщина пленки может быть определена сравнением по эталону.

2.4.2 Измерение толщины прозрачной пленки и показателя ее преломления

- 1. Подложка ложится на зеркало и на фотодиоде получается максимальный сигнал при нулевых углах лимба на поляризаторе и анализаторе.
- 2. Находится значение угла P1, при котором в пределах P=45-135⁰ сигнал минимален.
- 3. Находится значение угла A1, при котором в пределах A=0-90⁰ сигнал минимален.
- 4. В пределах $P = 135-225^0$ находится P2 для минимального сигнала.
 - 5. В пределах $A = 90-180^0$ находится A2 для минимального сигнала

6. Рассчитывается разность хода электрической и магнитной составляющих световой волны Δ и их разность фаз ψ .

$$\Delta = P1 + P2$$

 $\psi = \frac{1}{2}[A1 + (180 - A2)]$

7. По круговой диаграмме (типа «жук») определить показатель преломления и толщину пленки. На рис.2.4 представлена круговая диаграмма типа «жук».

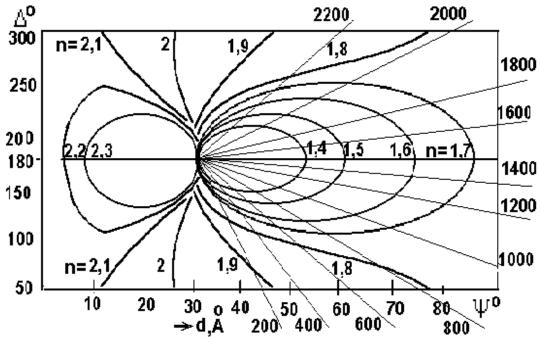


Рисунок 2.4 – Круговая диаграмма эллипсометра типа «жук»

В поле диаграммы цифрами обозначены показатели преломления. Толщины пленок в ангстремах находятся на лучах диаграммы.

8. Более точно толщина пленки определяется из прилагаемых к описанию прибора диаграмм зависимости толщины пленки $\delta = f(\psi), \delta = f(\Delta)$.

Примечание. Для стекла угол раствора эллипсометра (угол Брюстера равен 56^{0}). Углы «Р и А» могут находиться за пределами октантов.

3 Задание

3.1 Задание по измерению вакуума

3.1.1. Провести измерение вакуума в нескольких отпаянных термопарных датчиках давления ПМТ-2. Провести их градуировку и определить рабочий ток накала. Определить заводской разброс параметров.

- 3.1.2. Провести измерение высокого вакуума в нескольких отпаянных лампах ПМИ-2. Провести калибровку датчиков, установить эмиссию, провести установку «нуля».
- 3.1.3. Определить поток газопоглощения в датчиках по изменению давления в датчиках в течение времени.

Методические указания по измерению расхода газа

Важно правильно подключить расходомер. Он должен иметь забор воздуха из атмосферы, а не из элементов вакуумной системы. На стойке управления расход газа приведен в относительных единицах. Для получения абсолютных значений необходимо определить истинную скорость откачки насоса (по кривой производительности) и умножить ее на давление в системе. Расход измеряется в технической системе единиц. Его следует перевести в систему «СИ».

3.2 Задание по измерению адгезии пленки

- 1. Взять образец с нанесенной пленкой. Испытанием «на истирание» или «царапанием» определить адгезию пленки и возможный метод ее формирования.
- 2. Провести анализ пленки на микроскопе МИМ-7, визуально дать заключение о локальной адгезии пленки.

3.3 Задание по измерению расхода газа

- 1. Измерить расход потребляемого газа при давлениях в камере 100, 1, 0,1 мм рт ст
 - 2. Провести повторное измерение расхода при тех же давлениях
 - 3. Определить погрешность измерений

Методические указания по измерению толщины пленки

Толщина пленки является локальной величиной. Следует обратить внимание на «технологическую» и «истинную» толщину пленок.

3.4 Задание по измерению толщины пленки на эллипсометре

- 1. Снять локальное распределение толщины пленки.
- 2. Построить зависимости локальной толщины пленки в трех различных направлениях.

4 Содержание отчета

- 1 Отчет должен содержать все экспериментальные данные в соответствии с заданием, представленные в табличной и графической форме.
 - 2 Диаграмма распределения локальной толщины пленки
- 3 Сравнение газовыделения в датчиках давления, выделяющихся в процессе эксплуатации прибора (ПК 14).
- 4 Рекомендации: для производства каких приборов оптической электроники приемлемы данные по погрешностям при измерении давлений (ПК 20).
- 5 Презентацию по измерению зависимости давления во времени, зависимости параметров расхода газа от измерения к измерению. Привести данные по измерению толщины пленки для нескольких направлений (ПК21).
- 6 Привести эскизы и спецификацию фрагментов сертифицированных вакуумных элементов и оборудования, рекомендуемых для реализации процесса подготовки изделий и оборудования к технологическим операциям (ПК25).

Рекомендуемая литература

- 1. Электроника и микроэлектроника. Физико-технологические основы : Учебное пособие для вузов / А. А. Барыбин. М. : Физматлит, 2006.-423 с
- 2. Процессы микро- и нанотехнологии : учебное пособие для вузов / Т. И. Данилина [и др.] ; Федеральное агентство по образованию, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. Томск : ТУСУР, 2005. 316 с ISBN 5-86889-244-5
- 3. Вакуумная электроника. Физико-технические основы : учебное пособие для вузов / А. Д. Сушков. СПб. : Лань, 2004. 462[2] с
- 4. Основы микроэлектроники : учебное пособие для вузов / И. П. Степаненко. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2004. 488 с

Учебное пособие

Орликов Л.Н.

Подготовка к проведению технологического процесса

Методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Технология приборов оптической электроники и фотоники»

Усл. печ. л. . Препринт Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 634050, г.Томск, пр.Ленина, 40